固体表面への固体多層吸着

渡辺丕俊

(昭和58年9月20日受理)

Multilayer Solid Adsorption on a Solid Substrate

Hirotoshi WATANABE

(Received September 20, 1983)

緒 言

団体表面への多層吸着の問題を平均場近似を使って研 究する.この論文においてはグラファイト上に種々の不 活性ガスを吸着させた場合を例として考え,その時の原 子間に働くポテンシャルの強さを評価することに重点を おいた.

1 序

固体の表面にさまざまな原子や分子を物理吸着させる と,吸着した原子や分子の体系がそれまでと違った新し いいろいろな物理的性質を示す.

こうしたことの研究は近年の多くの実験手法の発達に よりはじめて可能となってきた. 平らな表面上に吸着が おきた体系では、できた層が二次元的特徴を持つことが 知られている.またその一方では被吸着固体の原子配列 の周期性を反映している整合一不整合転移や、方向秩序 などの様相も示すのである. これらの研究はこのところ めざましい発展を見せているが、これまでは主として単 一の吸着原子層(monolayer) に対してよくなされてきた. しかしながら最近徐々に多層 (multilayer) の吸着も物 質形成の仕方の一つの問題として興味が持たれ、いくつ かの代表的研究がなされるようになってきた¹⁾. Oliveira と Griffiths²⁾らは平らな固体表面上よりのポテンシャル のもとでの原子の吸着を格子ガスモデルで考え、それを 平均近似の方法で解くという非常にわかりやすい計算法 を示した. 同じやり方で Ebner³⁾は固体原子や吸着原子 の原子間ポテンシャルとして Lennard-Jones ポテンシ ャルを使って、キセノン固体へのアルゴン原子の多層吸 物理学研究室

着の問題を扱っている.こうした平均場近似以外にも, モンテカルロ法による計算⁴⁰や,密度関数や繰り込み群 による方法⁵⁰,ガウスモデルの方法⁶⁰などがこれまでに も行われている.

この論文においては、多層吸着の問題を平均場の近似 法を使って扱ってみる.この方法はすでに指摘されてい るとおり三次元ラフニング転移をみちびくような、一次 相転移の際の有限温度の揺らぎをうまくとり入れること ができないという欠点を持っている^の.しかしながらこ こではそうした問題よりも、固体表面からのポテンシャ ルや、吸着原子間のポテンシャルを丁寧にとりあつかう ことに主眼をおいてみる.これまでの論文の理論的計算 と実験で示されるところでは大きな差があるように見え るⁿ.これが近似方法の欠陥によるものか、採用したポ ,テンシャルが不適切であるのか知ることは興味あること である.したがって計算法のわかりやすい平均場近似を 使うかわりに、原子間ポテンシャルについては出来るだ け実際的だと考えられる扱いをしてみるのがこの論文の 目的である.

2 多層吸着のモデルと平均場近似

固体と気体の原子または分子が同時に存在する体系に おいてはそれら2種の物質の接触とするところで特別な 様子が見られる.気体の密度,圧力,温度などを変化さ せると固体表面に吸着した気体の原子または分子はさま ざまな相変化を示すことが知られている.この論文では 層状の吸着について興味を持って調べたが,吸着および 下地の原子の種類により吸着の仕方もいくつかに分類す ることができる¹⁹.これまでに多層吸着に関してなされ た代表的な実験としては,グラファイトの平面上にアル



77.3K で圧力を変化させた時のグラ ファイト表面へのクリプトンの吸着率 の実験、θは被覆率,P₀は飽和蒸気圧 を示す.

ゴン, クリプトンやキセノンを吸着させた場合とか, CdBr₂ や CdCl₂ にアルゴンやクリプリンを吸着させた 場合などがある^{7,8}. これらに おいては物質によって4 層から10層くらいまでの吸着層のあることが調べられて いる. 図1に A. Thomy と X. Duval らのレビュー⁷ によるグラファイト上へのクリプトンの吸着の様子を示 した.

これらの実験結果の吸着原子による相異は、吸着原子 のポテンシャルと吸着原子と下地の固体原子間のポテン シャルの強さで解析できるはずのものである.そこで前 節でも述べたように、この論文では固体表面上に原子が 吸着する時、その位置は格子点上に限るいわゆる格子モ デルを考え、計算方法としては Oliveira と Griffiths ら²⁰ が用いたような平均場近似を使うことにする.彼等の論 文に従い以下に公式の導びき方について一通り説明して おくことにする.

まず下地となる固体表面としてなめらかなものを考える. その表面を x-y 座標面とし、それに垂直に z 軸を

定める. *z*<0 の領域は固体により占められているもの とする. 固体の原子全体から, 吸着原子にはたらくポテ ンシャルを V(z) とする. 実際には固体表面の原子の周 期配列のために、このポテンシャルは x-y 座標への依 存体をもっているのであるが、この効果は非常に小さい し、実際一層以上の吸着ではほとんどの場合下地の周期 と不整合になる.この V(z) は z が非常に近い時,すな わち固体表面の近くにおいては固体原子のハードコアの ため強い斥力となるが、表面からはなれると弱い引力と なるのが普通である.そして固体の原子間隔程度の zの 値で最小値をとり, zの充分大きいところではzの約3 乗に反比例した引力となる.次に吸着原子間のポテンシ ャルを u(r,r') で書くことにする. ここでrとr' は二 つの原子の位置を示すものとする. 下地の固体に原子が 吸着してゆく時層状に吸着してゆき、その層の間隔は一 定であると仮定すると, n番目の吸着層の座標 zn は

 $z_n = z_1 + c(n-1)$ (2.1) で書き表わせる. z_1 は一層目の座標で, c は層間の距離 である.吸着原子の座標 r を層の番号 n と, その中での 位置 i を使って表わし, r = (ni) と書く, 先に述べたよ うに原子の吸着する位置 i を格子点上だと限るとこの系 のハルトトニアンH は次のように表わせる.

$$H = \frac{1}{2} \sum_{n, i, n', i'} u(ni, n'i') s_i^{n} s_{i'n'} + \sum_n V(z_n) \sum_i s_i^{n}$$
(2.2)

ここで *siⁿ* は1または0の値をとる. 大分配関数*Z*は 次のように定義される.

$$Z = \sum_{\{s_i^n\}} \exp - \beta (H - \mu N_0)$$
 (2.3)

和はすべての s_i^n の組合せに対してとる. また $\beta = \frac{1}{kT}$ で μ は化学ポテンシャル, N_0 は吸着原子数を表わすオ ペレーターである. ここでこうして考えた格子モデルに 対して, 各層ごとに平均場近似を行う. n 番目の層の平 均占有率を x_n とし, 各層の吸着格子点の数を N とする と

$$x_n = \sum_i \langle s_i^n \rangle / N \tag{2.4}$$

である.また

$$g(n, n') = \sum_{i'} u(ni, n'i') / N = g(n - n')$$

$$V_n = V(z_n)$$

という表示を使って平均場近似を行うと

$$Z = \sum_{(x_n)} \prod_{n} \frac{N!}{(N(1-x_n))!(Nx_n)!} \exp\left[-\beta N x_n \left(\frac{1}{2} \sum_{n'} g(n, n') x_n + (V_n - \mu)\right)\right]$$
(2.5)

となる. ここで $\{x_n\}$ はすべての Nx_n のときを表わして いる. 自由エネルギー Fは

$$F = -kT \ln Z \tag{2.6}$$

であるから、計算により $F=\sum [r_{-} \ln r_{-} + (1 - r_{-})]$

$$\begin{split} & Y = \sum_{n} [x_{n} \ln x_{n} + (1 - x_{n}) \ln (1 - x_{n}) \\ & + \beta \Big(\frac{1}{2} \sum_{n} g(n, n') x_{n} x_{n}' + (V_{n} - \mu) x_{n} \Big) \Big)] \end{split}$$

$$(2.7)$$

となるが、このFを極小にするような
$$x_n$$
は $x_n = 1/(1 + \exp \beta \{ \sum_{n'} g(n, n') x_n' + (V_n - \mu) \})$

(2.8)

で与えられる.吸着層が多くなり三次元固体と見なせる ようになると、固体表面より充分遠方の層に対しては他 のすべての層からのポテンシャルから寄与が等しいもの になってくる.またそこでは下地の固体よりのポテンシ ャルは充分小さいものになっている.その時の密度を x_{∞} で書くと

 $x_{\infty} = 1/(1 + \exp \beta(gx_{\infty} - \mu))$ (2.9) の関係が満たされるはずである.ここで

$$g = g(0) + 2\sum_{m=1}^{\infty} g(m)$$
 (2.10)

で定義される. さらに

$$t_n = x_n - x_\infty \tag{2.11}$$

$$h = \exp \beta(gx_{\infty} - \mu) \tag{2.12}$$

$$p_n = \sum_{n'>1} g(n-n')t_{n'} - x_{\infty} \sum_{m=n}^{\infty} g(m) + V_n$$
(2.13)

のように変数をかえると(2.8)式より

$$t_n = \frac{h(1 - \exp\beta p_n)}{1 + h(1 + \exp\beta p_n) + h^2 \exp(\beta p_n)} (2.14)$$

であるから, *pn* の満たすべき式は次のようである.

$$p_{n} = \sum_{n'>1} g(n-n') \\ \left[\frac{h(1-\exp\beta p_{n'})}{1+h(1+\exp\beta p_{n'})+h^{2}\exp(\beta p_{n'})} \right] \\ -x_{\infty} \sum_{m=n}^{\infty} g(m) + V_{n}$$
(2.15)

その時自由エネルギーは(2.7)式より

$$F = \sum_{n=1}^{\infty} \left[(t_n + x_{\infty}) \ln (t_n + x_{\infty}) + (1 - t_n - x_{\infty}) \ln (1 - t_n - x_{\infty}) + \exp \beta \left\{ \frac{1}{2} (t_n + x_{\infty}) (p_n + gx_{\infty} + V_n - 2\mu) \right\} \right]$$
(2.16)

で求めることができる.また被覆率 θ は

$$\theta = \sum_{n=1}^{\infty} (x_n - x_{\infty}) = \sum_{n=1}^{\infty} t_n$$
 (2.17)

で定義することにする.以上の公式を使えば求めたい物 理量を計算できることがわかったが,つぎに吸着原子に 対するポテンシャルの求め方を考えてみることにする.

3 吸着原子へのポテンシャル

前の節で述べたとおり吸着層の形成の仕方は吸着原子 と下地の固体の間のポテンシャル V(z) と吸着原子間の 2体のポテンシャル $u(\mathbf{r},\mathbf{r}')=u(\mathbf{r}-\mathbf{r}')$ により定まると考 える. Oliveira と Griffiths 6^{20} は第二吸着層以上の V(z)としてzの3乗に反比例する引力ポテンシャルを想定し た. Ebner³⁰はもう一歩基本的に考え吸着原子と下地の 固体の原子および吸着原子のそれぞれのポテンシャルに 対して Lennard-Jones 型のポテンシャルを仮定している. まず吸着原子間のポテンシャル $u(\mathbf{r})$ としては、よく知 られたように

$$u(r) = 4\epsilon \left\{ \left(\frac{\sigma}{r}\right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{r}\right)^6 \right\}$$
(3.1)

で与えられるとする. ここで $\epsilon \geq \sigma$ は Lennard-Jones の ポテンシャルパラメーターである. そして吸着原子間の 距離は隣接原子のポテンシャルを最小になるように定め $a=2^{1/6}\sigma$ とし, 各層は fcc 構造の (111) 面となるよう な格子でできていると考える. 次に Ebner は下地原子 から吸着原子へのポテンシャルとしては吸着原子への一 つ一つのポテンシャルである Lennard-Jones ポテンシ ャルを積分した型のものを採用し

$$V(z) = \frac{2\pi\varepsilon_{ac}}{a_c} \sigma_{ac}^2 \left\{ \frac{2\sigma_{ac}^{12}}{45z^9} - \frac{\sigma_{ac}^6}{3z^3} \right\}$$
(3.2)

とした. ここで ϵ_{ac} と σ_{ac} は下地原子と吸着原子間の Lennard-Jones ポテンシャルのパラメーターであり, a_c は下地原子1個あたりの一つの層の中での面積とした.

このポテンシャルを最小とする z の値は $\left(\frac{2}{5}\right)^{1/6}\sigma_{ac}$ である. Ebner はこうしたポテンシャルの型を用いて解析 を行っている. この (3.2) 式の V(z) をここでは $V_1(z)$ という記号で表わすことにする. 前に述べたとおりこれらのポテンシャルのとりかたに より結果は大変異なったものになると考えられるので, この論文においてはポテンシャルのとり方についてさら

表1 不活性ガス原子と炭素原子間,および不活性ガス原子間のLennard-Jones ポテンシャルのパラメータの値の表。参考文献11)を参照。また K は本文(3.7)式で与えられる。

	$\stackrel{\epsilon_{ac}}{({ m meV})}$	σ_{ac} (Å)	K (meV)	و (meV)	σ (Å)
He	1.40	2. 74	11. 7	0. 922	2.64
N _e	2. 77	2. 80	24. 8	3. 62	2. 76
Ar	5.10	3. 10	84. 2	12.2	3. 35
Kr	6. 08	3. 21	123. 7	17.4	3. 57
Xe	7. 17	3. 36	191. 8	24. 2	3. 89

に慎重に扱ってみる.まず下地よりのポテンシャル V(z)を求めるのに Ebner の論文においては $z \leq 0$ の領域はす べて固体原子が均一につまっていると考えて積分操作を 行った.しかしながら下地の固体原子の層間距離をdと すると, z座標でみて d/2 までの領域で積分すべきもの であろう.こうして考えた下地のポテンシャルを $V_2(z)$ とすると明らかに (3.2) 式を使って

$$V_2(z) = V_1\left(z - \frac{d}{2}\right)$$
(3.3)

となる. いずれにせよ V_1 と V_2 ともに積分だけを使っ た近似であるから第一と第二の吸着層に対してはあまり よい近似とはなっていないであろうと考えられる.

そこでもう一つの下地よりのポテンシャルの近似方法 を考える.下地の固体原子を表面に平行な層からできて



でありグラファイト層間距難でスケールしてある。

(52)



図3 グラファイト表面の N. 原子に働くポテンシャルを3通りの方法で 求めたもの.

いるとし、その j 番目の層からの吸着原子へのポテンシ となる. ャルの寄与を求めてやる.原子の周期配列を考えてフー リェ分解し、その第0近似の計算である積分を V₍₂₎ と するとの

$$V_{(z)}{}^{j} = \frac{2\pi}{a_c} \epsilon_{ac} \left[\frac{2}{5} \left(\frac{\sigma_{ac}}{z+jd} \right)^{10} - \left(\frac{\sigma_{ac}}{z+jd} \right)^4 \right]$$
(3.4)

となる. この和をとることにより求まるポテンシャルを $V_{3}(z) \ge j = z \ge z$

$$V_{\delta}(z) = \sum_{j=0}^{\infty} V_{(z)}{}^{j}$$
$$= \frac{2\pi}{a_{c}} \epsilon_{cz} \frac{\sigma_{ac}{}^{6}}{d^{4}} \left[\frac{2}{5} \left(\frac{\sigma_{ac}}{d} \right)^{6} \zeta \left(10, \frac{z}{d} \right) \right.$$
$$\left. - \zeta \left(4, \frac{4}{d} \right) \right]$$
(3.5)

ここでζはツェーター関数で次のように定義される.

$$\zeta(n, x) = \sum_{i=0}^{\infty} (i+x)^{-n}$$

このツェーター関数を近似表示することにより10) $2\pi\varepsilon_{ac}\sigma_{ac}^{6}$ (2 / σ_{ac})⁶ / d^{10}

$$V_{3}(z) = \frac{2\pi c_{ac} c_{ac}}{a_{c} d^{4}} \left\{ \frac{z}{5} \left(\frac{b_{ac}}{d} \right) \left(\frac{u^{-1}}{z^{10}} + \frac{d^{9}}{9(z+0.72d)^{9}} \right) - \left(\frac{d^{3}}{3(z+d)^{3}} + \frac{d^{4}}{z^{4}} + \frac{d^{4}}{2(z+d)^{4}} + \frac{d^{5}}{3(z+d)^{5}} - \frac{d^{7}}{6(z+d)^{7}} \right) \right\}$$

$$(3.6)$$

と書き表わすことができる.

以上の3つのポテンシャルを数値的に比較してみる. 変数をスケールしなおして $e=\sigma_{ac}/d$ $\tilde{z}=z/d$ として





図4 グラファイト表面の Ar 原子に働くポテンシャルを3通りの方法 で求めたもの.

 $K = \frac{2\pi\varepsilon_{ac}}{a_c} \sigma_{ac}^2 e^4 \tag{3.7}$

とおくと

$$V_{1}(z) = KV_{1}(\tilde{z})$$

$$(3.8)$$

$$V_{1}(z) = K\widetilde{V}(z) = K\widetilde{V}(z)$$

$$(3.8)$$

$$V_{2}(z) = K \tilde{V}_{3}(\tilde{z})$$
(3.10)
$$V_{3}(z) = K \tilde{V}_{3}(\tilde{z})$$
(3.10)

$$\tilde{V}_{1}(\tilde{z}) = \frac{2e^{6}}{45} \frac{1}{\tilde{z}^{3}} - \frac{1}{3\tilde{z}^{3}}$$
 (3.11)

$$\begin{split} \widetilde{V}_{3}(\widetilde{z}) &= \frac{2e^{6}}{5} - \left(\frac{1}{\widetilde{z}^{10}} + \frac{1}{9(\widetilde{z}+0.72)^{9}}\right) \\ &- \left(\frac{1}{3(\widetilde{z}+1)^{3}} + \frac{1}{\widetilde{z}^{4}} + \frac{1}{2(\widetilde{z}+1)^{4}} + \frac{1}{3(\widetilde{z}+1)^{5}} - \frac{1}{6(\widetilde{z}+1)^{7}}\right) \quad (3.12) \end{split}$$

である.表1にグラファイトを下地とし、その上にいろ いろな不活性ガスを吸着させる時のパラメータの値がの せてある.この値は M. Cole と J. Klein ら¹¹⁾の論文で引 用してある数値を参考にしている.d=3.37 Å, $a_c=2.62$ Å² とした.これらの数値を使ってポテンシャルを求め ると $\hat{V}_1(\hat{z}), \hat{V}_2(\hat{z}), \hat{V}_3(\hat{z})$ は図2から図6のようにな る.これらの図から、 $V_2(z)$ は2ないし3層目以上の吸 着原子に対しては適当なポテンシャルを与えてくれるよ うに見える.しかしながら全体的に言えば $V_3(z)$ が他の ポテンシャルの関数よりすぐれていると言える.(3.12) の式から、それらのボテンシャルの最小値を与える z 座 標の値、すなわち z1 を求めることができる.表2にはそ れをdでスケールした \hat{z}_1 の値がのせてある.



図5 グラファイト表面の Kr 原子に働くポテンシャルを3通りの方法 で求めたもの.

つぎに吸着原子層間のボテンシャルについて求めることにしよう.ここでも (2.5) 式で使ったような平均場述 似の考え方にしたがって吸着原子間どうしのボテンシャ ルをそのまま扱うという見方でなしに,ある吸着原子に 対して,1つの吸着層から働くポテンシャルという形で 相互作用をとらえることにする.そうすると n 番目の吸 着層全体と,n' 番目の吸着層上の1原子との相互作用で あるg(n-n') は,面内の和を積分でおきかえることの 近似を使い

$$g(n-n') = \frac{2\pi\varepsilon\sigma^2}{s} \left[\frac{2}{5} \left(\frac{\sigma}{(n-n')c} \right)^{10} - \left(\frac{\sigma}{(n-n')c} \right)^4 \right]$$
(3.13)

である. ここで ε, σ は先にのべたように (3.1) 式の

Lennard-Jones のパラメーターであり、 s は吸着層内の 1原子当りの面積、 c.は (2.1) 式のように吸着層間の距離 離とした. この式からわかるとおり吸着層間の距離は一 定であると近似している. さらにこの式から層間のポテ ンシャルが最小であるように c を定めるとすると $c=\sigma$ となる.

(3.13) 式は異った層の間の相互作用であるが, 同一 面内での原子間のポテンシャルの和も必要である. 吸着 した1原子と同一面内の他のすべての吸着原子間のポテ ンシャルは吸着原子が格子間隔 a の三角格子を使ってい るとし, (3.1) 式の格子和をとると¹²⁾

$$g(0) = 4\varepsilon \left[A_{12} \left(\frac{\sigma}{a} \right)^{12} - A_6 \left(\frac{\sigma}{a} \right)^6 \right]$$
(3.14)

となることがわかる. ここで A12=6.00981, A6=6.37588



表 2 吸着原子の種類によりグラファイトから 働くポテンシャル \hat{V}_3 の最小値を与える dでスケールされた座標 \hat{z}_1 ,および吸着面内 における本文の(3.15)式で与えられる原 子間距離 a の表.

	\boldsymbol{z}_1	a (Å)
He	0. 810	2. 93
Ne	0. 828	3. 07
Ar	0. 917	3. 72
Kr	0. 947	3. 97
Xe	0. 991	4. 32

という値である. この格子定数 a は (3.14) 式が最小に なるように求めると $a = (2A_{12}/A_6)^{1/6}\sigma = 1.\ 1115\ \sigma \tag{3.15}$

と定まる.表2に各吸着原子の場合の値をしるしておく. Ebner のように,最近接原子間のポテンシャルを最小に するように決めた時は, $a=\sqrt[3]{2\sigma}$ となり上の値より小 し大きくなる.また (3.13)式での1原子当りの面積*s* は

 $s=\sqrt{3}/2 \cdot a^2$ (3.16) で与えられる。

4 まとめ

多層吸着の場合吸着原子に下地の原子と他の吸着原子 から作用するポテンシャルの大きさを Lennard-Jones の 二体のポテンシャルの和として求めてみた.この際量子 効果によるものや下地の原子の周期構造によるもの,ま た三体力によるものなどは小さいとして考慮していない. しかしながら温度効果によるミニマム・ポテンシャルの 大きさや位置の変化などは考える必要があろう^{III}. いず れにせよ2層目や3層目以上での吸着原子に働く下地か らのポテンシャルは相当小さいものであり,吸着層ので き方はこの減小の仕方を微妙に反映したものとなること が考えられる.最近の吸着原子の種類をいろいろ変えた 実験⁶⁰では,吸着層の作られ方がポテンシャルの強さか ら予想されるものと異っていることが示された.今後こ うした研究の積み重ねが期待される.われわれはこの論 文で求めたポテンシャルと,平均ポテンシャルの近似を 使うとどのような多層吸着の結果が得られるか次に考え てみたい.

参考文献

 R. Pondit, M. Schick, and M. Wortis: Phys. Rev. B26, 5112 (1982)

- M. J. de Oliveira and R. B. Griffiths : Surf. Sci. 71, 687 (1978)
- 3) C. Ebner : Phys. Rev. A22, 2776 (1980)
- I. M. Kim and D. P. Landau : Surf. Sci. 110, 415 (1981)
- 5) W.F. Saam : Surf. Sci. 125, 253 (1983)
- 6) J. D. Weeks : Phy. Rev. B26, 3998 (1982)
- A. Thomy, X. Duval, and J. Regnier : Surf. Sci. Rep. 1, 1 (1981)
- J. L. Seguin, J. Suzane, J. G. Dash et al : Phys. Rev. Let. 51, 122 (1983)
- W. A. Steele : "The Introduction of Gases with Solid Surfaces", Pergamon, New York (1973)
- 10) W.A. Steele : J. of Phys. Chem. 82, 817, 1978
- M. W. Cole and J. R. Klein : Surf. Sci, 124, 547 (1983)
- 12) I. J. Zucker : J. Math. Phys. 15, 187 (1974)

Summary

The multilayer physisorption on an attractive solid substrate is investigated by the mean-field approximation. The model of adsorption of noble gases on the basal plane surface of graphite is studied, and the interaction potential for an adatom is evaluated so as to simulate the model as nearly as possible.